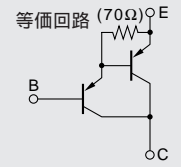


ダーリントン

2SB1647



シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタトランジスタ(2SD2560とコンプリメンタリ) 用途：オーディオ、シリーズレギュータ、一般用

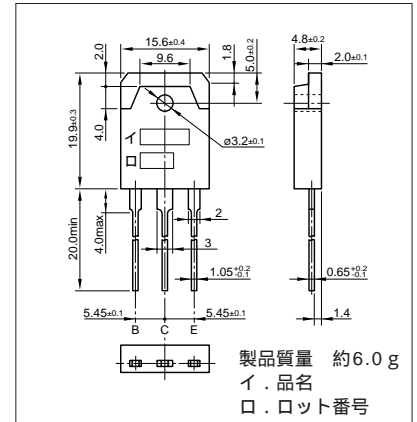
絶対最大定格 (Ta=25)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	-150	V
V _{CEO}	-150	V
V _{EBO}	-5	V
I _c	-15	A
I _B	-1	A
P _c	130(T _c =25)	W
T _j	150	
T _{stg}	-55 ~ +150	

電気的特性 (Ta=25)

記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} = -150V	-100max	μA
I _{EBO}	V _{EB} = -5V	-100max	μA
V(BR)CEO	I _c = -30mA	-150min	V
h _{FE}	V _{CE} = -4V, I _c = -10A	5000min	
V _{CE(sat)}	I _c = -10A, I _B = -10mA	-2.5max	V
V _{BE(sat)}	I _c = -10A, I _B = -10mA	-3.0max	V
f _T	V _{CE} = -12V, I _E = 2A	45typ	MHz
C _{OB}	V _{CB} = -10V, f = 1MHz	320typ	pF

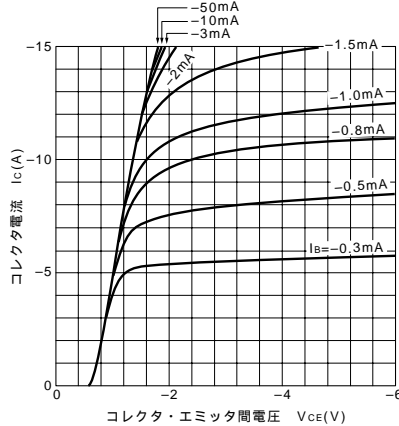
外形図 MT-100(TO3P)



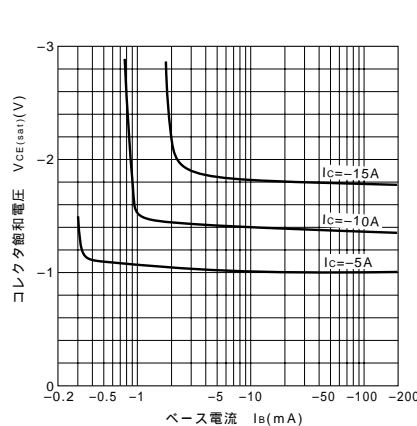
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _c (A)	V _{BB1} (V)	V _{BB2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-40	4	10	-10	5	-10	10	0.7typ	1.6typ	1.1typ

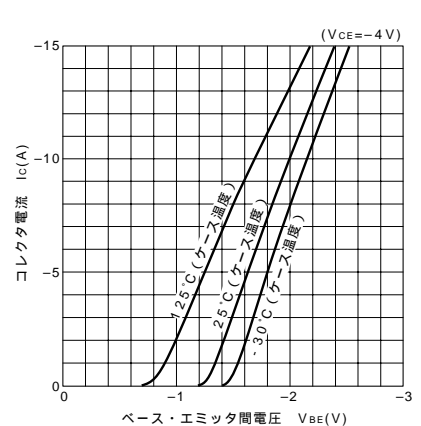
I_c-V_{CE}特性 (代表例)



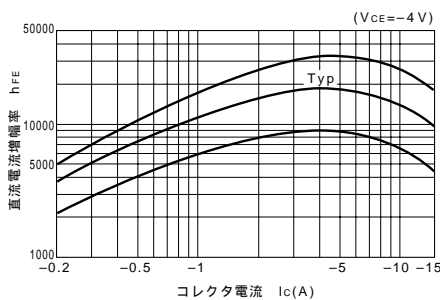
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



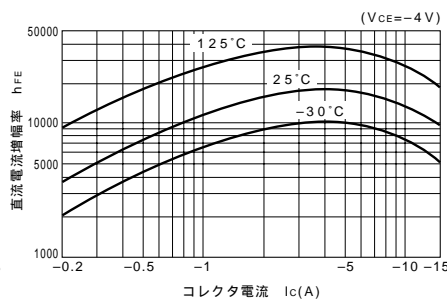
I_c-V_{BE}温度特性 (代表例)



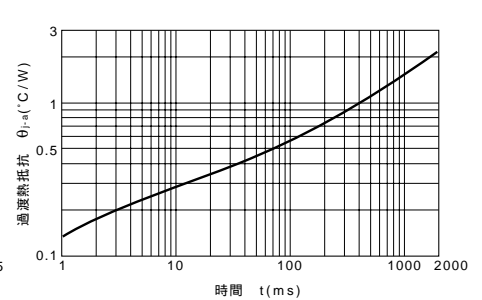
h_{FE}-I_c特性 (代表例)



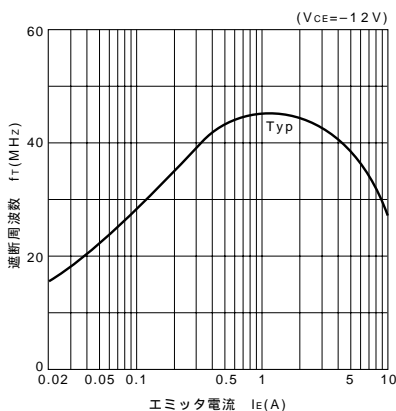
h_{FE}-I_c温度特性 (代表例)



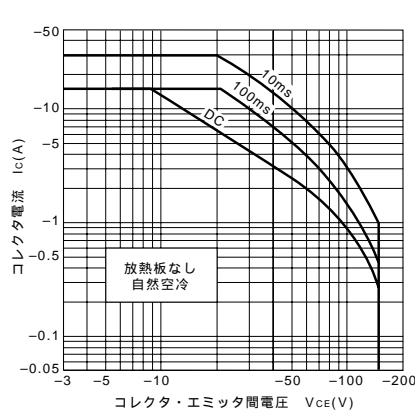
θ_{j-a}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_c-T_a定格

